

# Silicon Diode

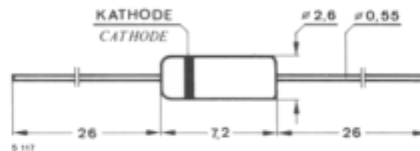
## **BA147/50**

50V / 150mA

# DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1977

**BA 147/...****Silizium-Diode  
Silicon diode****Anwendungen:** Allgemein**Applications:** General purpose**Abmessungen in mm  
Dimensions in mm**

Normgehäuse  
Case  
51 A 2 DIN 41 880  
JEDEC DO 7  
Gewicht · Weight  
max. 0,2 g

**Absolute Grenzdaten  
Absolute maximum ratings**

Sperrspannung Reverse voltage	<b>BA 147/25</b>	$U_R$	25	V
	<b>BA 147/50</b>	$U_R$	50	V
	<b>BA 147/100</b>	$U_R$	100	V
	<b>BA 147/150</b>	$U_R$	150	V
	<b>BA 147/230</b>	$U_R$	230	V
	<b>BA 147/300</b>	$U_R$	300	V
Periodischer Durchlaßspitzenstrom Repetitive peak forward current		$I_{FRM}$	500	mA
Durchlaßstrom Forward current		$I_F$	150	mA
Sperrschichttemperatur Junction temperature		$t_j$	150	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range		$t_{stg}$	-55...+150	°C

## BA 147/...

---

### Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung  
Junction ambient

$l = 4 \text{ mm}$ ,  $t_L = \text{konstant}$   
constant

$R_{thJA}$

500 °C/W

### Kenngößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$ , falls nicht anders angegeben  
unless otherwise specified

Durchlaßspannung  
Forward voltage

$I_F = 50 \text{ mA}$

$U_F$

1 V

Sperrstrom  
Reverse current

$U_R = 25 \text{ V}$	<b>BA 147/25</b>	$I_R$	500	nA
$U_R = 50 \text{ V}$	<b>BA 147/50</b>	$I_R$	500	nA
$U_R = 100 \text{ V}$	<b>BA 147/100</b>	$I_R$	1	$\mu\text{A}$
$U_R = 150 \text{ V}$	<b>BA 147/150</b>	$I_R$	1,5	$\mu\text{A}$
$U_R = 230 \text{ V}$	<b>BA 147/230</b>	$I_R$	2	$\mu\text{A}$
$U_R = 300 \text{ V}$	<b>BA 147/300</b>	$I_R$	3	$\mu\text{A}$

$t_j = 100^\circ\text{C}$

$U_R = 10 \text{ V}$	<b>BA 147/25, BA 147/50</b>	$I_R$	15	$\mu\text{A}$
$U_R = 50 \text{ V}$	<b>BA 147/100</b>	$I_R$	30	$\mu\text{A}$
$U_R = 100 \text{ V}$	<b>BA 147/150</b>	$I_R$	50	$\mu\text{A}$
$U_R = 150 \text{ V}$	<b>BA 147/230</b>	$I_R$	75	$\mu\text{A}$
$U_R = 200 \text{ V}$	<b>BA 147/300</b>	$I_R$	100	$\mu\text{A}$

# BA 147/ ...

